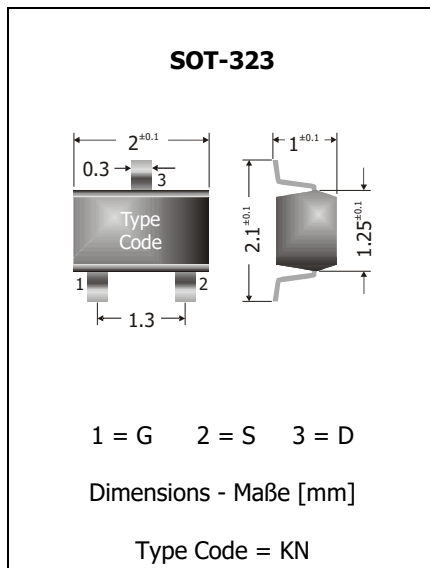


**MMFTN3018W**  
**N-Channel Enhancement Mode FET**  
**N-Kanal FET – Anreicherungstyp**

$I_D$	= 100 mA	$V_{DSS}$	= 60 V
$R_{DS(on)1}$	< 8 $\Omega$	$P_{tot}$	= 200 mW
$T_{jmax}$	= 150°C		

Version 2017-06-26

**Typical Applications**

Signal processing, Drivers,  
 Logic level converter  
 Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

Fast switching times  
 Compliant to RoHS, REACH,  
 Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled	3000 / 7 <sup>n</sup>
Weight approx.	0.01 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung, Treiberstufen,  
 Logikpegelwandler  
 Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Schnelle Schaltzeiten  
 Konform zu RoHS, REACH,  
 Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

		<b>MMFTN3018W</b>	
Drain-Source-voltage – Drain-Source-Spannung	$V_{DS}$	60 V	
Gate-Source-voltage – Gate-Source-Spannung	$V_{GS}$	D open	$\pm 20$ V
Power dissipation – Verlustleistung	$P_{tot}$	200 mW	
Drain current – Drainstrom	$I_D$	dc	100 mA
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	$I_{DM}$	400 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	$T_j$	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_s$	-55...+150°C	

**Characteristics****Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$		
		Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung	$V_{(BR)DSS}$	30 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom	$I_{DSS}$	–	–	1 $\mu\text{A}$
Gate-Source leakage current – Gate-Source Leckstrom	$\pm I_{GSS}$	–	–	1 $\mu\text{A}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung	$V_{GS(th)}$	0.8 V	–	1.5 V

<sup>1</sup> Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

<sup>2</sup>  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben

## Characteristics

## Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand					
$V_{GS} = 4\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}$	$R_{DS(on)}$		–	–	8 $\Omega$
$V_{GS} = 2.5\text{ V}, I_D = 1\text{ mA}$					
Forward Transfer Admittance – Übertragungssteilheit					
$V_{DS} = 3\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}$	$g_{FS}$		20 mS	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität					
$V_{DS} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{iss}$		–	13 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität					
$V_{DS} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{oss}$		–	9 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität					
$V_{DS} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{rss}$		–	4 pF	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		$R_{thA}$	< 625 K/W <sup>1)</sup>		

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)

**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss